

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>4</sup> G02F 1/13	(11) 공개번호 특 1989-0017560	(43) 공개일자 1989년 12월 16일
(21) 출원번호	특 1989-0005609	
(22) 출원일자	1989년 04월 28일	
(30) 우선권주장	119919 1988년 05월 17일 일본(JP)	
(71) 출원인	세이코 엡슨 가부시키 가이사 야마무라 가쯔미 일본국 도오교도 신쥬꾸꾸 니시신쥬꾸 2쥬메 4반 1고	
(72) 발명자	미사와 도시유키 일본국 나가노켄 스와시 오와 3쥬메 3반 5고 세이코 엡슨 가부시키 가이사 나이 오시마 히로유키 일본국 나가노켄 스와시 오와 3쥬메 3반 5고 세이코 엡슨 가부시키 가이사 나이	
(74) 대리인	이병호, 최달용	

심사청구 : 없음

(54) 액티브 매트릭스 패널

요약

내용 없음

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

액티브 매트릭스 패널

[도면의 간단한 설명]

제 1 도는 본 발명의 실시예, 즉 주변에 구동회로를 직접화한 액티브 매트릭스 패널을 나타낸도. 제2A도 내지 제2F도는 제 1 도에 있는 구동회로의 상세한 구성예를 나타낸도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

복수의 게이트선, 복수의 소스선 및 박막 트랜지스터를 갖춘 화소 매트릭스가 형성된 제 1 의 투명기판 라 제 1 의 투명기판에 대향 배치된 제 2 의 투명기판과 제1 및 제 2 투명기판간에 설치된 액정에서 이루는 액티브 매트릭스 패널에 있어서, 제 1 투명기판상에 실리콘 박막에 의한 상보형 박막 트랜지스터에서 이루는 게이트선 구동회로 및 실리콘 박막에 의한 상보형 박막 트랜지스터에서 이루는 소스선 회로의 적어도 한쪽을 구비하고, 상기 화소 매트릭스를 구성하는 트랜지스터는 상기 게이트선 구동회로 내지 소스선 구동회로를 구성하는 P형 박막 트랜지스터 및 N형 박막 트랜지스터중의 한쪽과 동일한 단면 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 패널.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 게이트선 구동회로 및 상기 소스선 구동회로는 상보형 박막 트랜지스터에 의한 스타팅 시스트 레지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 패널.

청구항 3

제 1 또는 2 항에 있어서, 상기 게이트선 구동회로 및 소스선 구동회로는 P형 및 N형 박막 트랜지스터에서 이루고 상기 P형 박막 트랜지스터는 소스영역 및 드레인 영역에 억셉터 불순물을 포함하고, 상기 N형 박막 트랜지스터는 소스영역 및 드레인 영역에 억셉터 불순물과 그 억셉터 불순물 보다도 고농도의 도너

불순물을 포함하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 패널.

**청구항 4**

제 1 또는 2항에 있어서, 상기 게이트선 구동회로 및 소스선 구동회로는 P형 및 N형의 박막 트랜지스터에서 이루어지며, 상기 N형 박막 트랜지스터는 소스영역 및 드레인 영역에 도너불순물을 포함하고, 상기 P형 박막 트랜지스터는 소스영역 및 드레인 영역에 도너 불순물과 도너 불순물 보다도 그농도의 억셉터 불순물을 포함하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 패널.

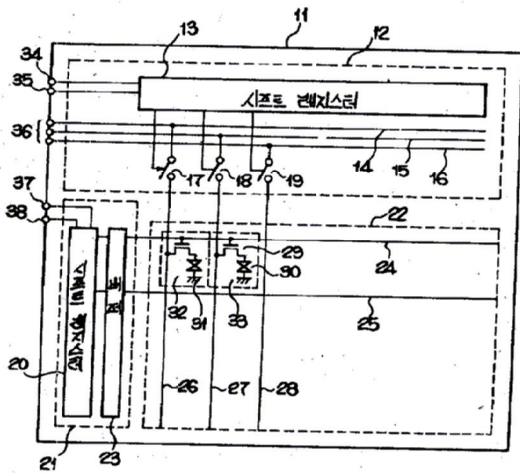
**청구항 5**

제 1 또는 2 항에 있어서, 상기 게이트선 구동회로 및 소스선 회로를 구성하는 P형 및 N형의 박막 트랜지스터의 게이트 길이는 상기 화소 매트릭스를 구성하는 박막 트랜지스터의 게이트 길이보다도 짧게 형성된 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 패널.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면**

도면1



도면2

